

# 第2回ポスター発表展

本研究会は界面ナノ現象を明らかにすることでウェットプロセスに関する学問を構築し、次世代へと教育できる環境を整えています。同時に本研究会成果物の実行者である若手の主体性が極めて重要です。そこで若手に発表の機会を与え、発表形式をポスターとすることによりベテラン技術者とのFace to faceの議論を通じ、若手の主体性強化を目的とし発表展を企画します。

なお当日は10周年記念 第20回カサロス（懇親会）を同日開催します。

## 若手のポスター発表展 —ベテランとの議論に打ち勝て！—

■主催：応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会

■第2回ポスター発表展実行委員

実行委員長 安藤景太（慶應義塾大学）

実行委員 真田俊之（静岡大学），吉水康人（東芝），萩本賢哉（ソニー）  
國本文智（フィッツ），荒木浩之（SCREENセミコンダクターソリューションズ）  
矢野大作（オルガノ），吉田勇喜（関東化学）

■日時：2016年3月18日（金） 13：00～17：00 ※12：30より受付開始

■場所：慶應義塾大学 日吉キャンパス（来往舎）  
（〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1）

《交通》日吉駅（東急東横線、東急目黒線／横浜市営地下鉄グリーンライン）徒歩1分  
※東急東横線の特急は日吉駅に停車しません。

■参加費：無料

※ただし、事前に参加のお申込みをお願い致します。

■申込締切：2016年3月4日（金）

■定員：60名 ※定員に限りがあるので早めに参加お申込みください

■参加申込方法：e-mailにて下記までお申し込み下さい。

申込先：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1

関東化学株式会社 電子材料事業本部技術部開発課

吉田勇喜 e-mail：yoshida-yuki@gms.kanto.co.jp



## 詳細内容

- プログラム： 開会の辞・司会進行 吉水康人（東芝）
- |     |             |                                                |
|-----|-------------|------------------------------------------------|
| (1) | 13:00~13:15 | 「開会の辞」                                         |
| (2) | 13:15~13:45 | 「一分間ショートプレゼン」                                  |
|     | 13:45~14:00 | (休憩・会場準備)                                      |
| (3) | 14:00~16:20 | 「ポスターセッション」                                    |
|     | 16:20~16:30 | (休憩・会場準備)                                      |
| (4) | 16:30~16:45 | 「表彰」「写真撮影」                                     |
| (5) | 16:45~17:00 | 「閉会の辞」                                         |
|     | 18:00~20:00 | 「懇親会（カサロス）」（会場：自由が丘）<br>参加ご希望の方はお申し込み時にお知らせ下さい |

■発表内容（敬称略）

	タイトル	発表者	所属
1	超音波洗浄における溶存酸素量の影響	山下 達也	慶應義塾大学
2	各種膜付半導体ウェーハのPVAロールブラシとの摩擦力測定	西尾 賢哉	静岡大学
3	液滴衝突誘起のせん断流による粒子剥離メカニズムに関する数値解析	近藤 智貴	慶應義塾大学
4	超純水中の10nm微粒子測定技術	市原 史貴	オルガノ株式会社
5	リンス工程におけるシリコン基板上への微粒子付着挙動の研究	中田 耕次	栗田工業株式会社
6	DHFプロセスにおける微小パーティクル低減	竹口 博史	東京エレクトロン九州
7	希薄アンモニア水によるウェーハ帯電防止効果	川上 雅之	オルガノ株式会社
8	微小空間におけるウェットエッチング挙動の考察	奥山 敦	ソニー株式会社
9	液柱および液滴列衝突による微細孔への液体浸入特性	山口 えり	静岡大学
10	SiO <sub>2</sub> 固体面における水およびアルコールの表面吸着の分子動力学解析	林 拓弥	大阪大学 大学院
11	クリーンルーム雰囲気中の微量ガスとウォーターマーク	田坂 耕一	ラムリサーチ株式会社
12	界面ナノ電子化学研究会 吸着WG活動報告	小佐井 一樹	東京エレクトロン九州
13	VPD-ICP-MSによるシリコンウェーハ表面の金属汚染「局所」分析法の検討	池内 満政	株式会社 イアス
14	IPA中におけるMetalの除去効果	橋迫 史明	日本インティグリス株式会社
15	Si基板のBMDによるゲッターリングの深さ方向分布解析	大野 カー	ソニー株式会社
16	マルチスタックプロセス向け洗浄液に要求される特性	並木 拓海	東京応化工業株式会社
17	金属腐食抑制のための酸化性物質除去技術	蔦野 恭平	オルガノ株式会社
18	GeおよびSiGeに対する表面処理	尾辻 正幸	SCREENセミコンダクターソリューションズ
19	MOD法によるGaN表面へのNiO粒子の形成と調査	喜田 弘文	北海道大学
20	金属触媒ウェットエッチングを用いたシリコンの微細加工	伊藤 冬馬	株式会社東芝セミコンダクター & ストレージ社
21	陽極反応を用いたGaN表面の酸化膜形成	枝元 将彰	北海道大学
22	太陽電池窓層への応用を目指した電気化学成長ZnO薄膜の表面形態制御	今西 剛士	大阪府立大学
23	電気化学的手法によるCu <sub>2</sub> O/InPヘテロ界面形成と光学特性評価	近江 沙也夏	北海道大学

## カサロス（懇親会）の詳細ご案内

- 主催：応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会
- 日時：2016年3月18日（金） 18：00～20：00
- 参加費：6,000円 当日参加7,000円（学生 無料）  
※カサロス会費について当日会場にてお支払い下さい。領収書を発行します。
- 申込締切：2015年3月4日（金）
- 定員：60名 ※定員に限りがあるので早めに参加お申込みください

### カサロス会場案内

- 会場名（店名）：  
『CLANN』  
東京都目黒区自由が丘1-8-18 ノーブルビル 3F  
Tel 03-3725-9116  
<http://clann-irishpub.com/>

《交通》  
東急東横線自由が丘駅 南口 徒歩15秒



(カサロス会場)  
「CLANN」

- 参加申込方法：e-mailにて下記までお申し込み下さい。  
申込先：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1  
関東化学株式会社 電子材料事業本部技術開発課  
吉田勇喜 e-mail：yoshida-yuki@gms.kanto.co.jp